

議題	窒化物及び混晶半導体デバイス、及び一般
-----------	---------------------

電子部品・材料研究会(CPM)	
専門委員長	高野 泰 (静岡大学)
副委員長	野毛 悟 (沼津高専)
幹事	圓佛 晃次 (NTT), 佐藤 知正 (神奈川大)
幹事補佐	小館 淳一 (NTT), 岩田 展幸 (日大)

電子デバイス研究会(ED)	
専門委員長	原 直紀 (富士通研)
副委員長	前澤 宏一 (富山大)
幹事	上田 哲三 (パナソニック), 葛西 誠也 (北大)
幹事補佐	松永 高治 (NEC), 鈴木 寿一 (北陸先端大)

レーザ・量子エレクトロニクス研究会(LQE)	
専門委員長	松尾 慎治 (NTT)
副委員長	近藤 正彦 (阪大)
幹事	田中 有 (富士通研), 有賀 博 (三菱電機)

日時	2013年11月28日(木) 10:30 - 17:30 2013年11月29日(金) 09:30 - 17:10
会場名	大阪大学 吹田キャンパス 理工学図書館ホール
住所	〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2
交通案内	阪急電車千里線:北千里駅(終点)下車東へ徒歩約15分, 大阪モノレール:阪大病院前駅下車徒歩約5~15分, 阪急バス:・千里中央発「阪大本部前行」、「茨木美穂ヶ丘行」阪大医学部前または阪大本部前下車 徒歩約5~15分・北千里発「阪大病院線」, 近鉄バス・阪急茨木市駅発「阪大本部前行」(JR茨木駅経由)いずれも、阪大医学部前または阪大本部前下車 徒歩約5~15分 http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
会場世話人 連絡先	工学研究科 電気電子情報工学専攻 近藤正彦 06-6879-7765
お知らせ	◎28日研究会終了後、懇親会を予定していますので御参加ください。

11月28日(木) 午前	
InGaN 半導体レーザのワット級高出力化とその応用展開	○ 萩野裕幸 ・ 左文字克哉 ・ 吉田真治 ・ 瀧川信一 ・ 森本 廉 ・ 瀧澤俊幸 ・ 春日井秀紀 ・ 山中一彦 ・ 片山琢磨 (パナソニック)
m面 GaNの異方性ドライエッチングによるテクスチャーの形成とこれによるLED光取り出し効率の向上	○ 藤田稔之 ・ 山田篤志 ・ 井上 彰 ・ 加藤亮 ・ 横川俊哉 (パナソニック)
350nm 紫外 LED 光取り出し効率改善に関する研究	○ 中嶋 翼 ・ 竹田健一郎 ・ 岩谷素顕 ・ 上山智 ・ 竹内哲也 ・ 赤崎 勇 (名城大)・ 天野 浩 (名大)
内部集光レーザを用いた窒化物半導体デバイス用基板のそり制御 ~ シリコン基板への応用 ~	○ 青田奈津子 ・ 会田英雄 ・ 武田秀俊 (並木精密宝石)
表面活性化ボンディング法により形成したSi/SiCヘテロ接合の電気特性	○ 西田将太 ・ 梁 剣波 ・ 森本雅史 ・ 重川直輝 (阪市大)・ 新井 学 (新日本無線)
表面活性化ボンディング法によるタンデム太陽電池の作成	○ 梁 剣波 ・ 西田将太 ・ 森本雅史 ・ 重川直輝 (阪市大)
InGaN/GaN MQW 太陽電池における	○ 渡邊則之 ・ 満原 学 ・ 横山春喜 (NTT)・

MQW 構造最適化に関する考察	梁 劍波 ・ 重川直輝 (阪市大)
GaN 自立基板上低キャリア厚膜 n-GaN ショットキー接触の評価	○ 塩島謙次 ・ 木原雄平 ・ 青木俊周 (福井大)・ 金田直樹 ・ 三島友義 (日立金属)
低 Mg ドープ p-GaN ショットキー接触の AC 動作	○ 塩島謙次 ・ 青木俊周 (福井大)・ 金田直樹 ・ 三島友義 (日立金属)
高輝度電子ビーム源を目指した NEA 表面 p-GaN の量子効率	○ 前川拓也 ・ 本田善央 ・ 天野 浩 ・ 西谷智博 (名大)
MOVPE 法による GaN 及び AlGaIn への C ドーピングに関する研究	○ 若杉侑矢 ・ 本田善央 ・ 天野 浩 (名大)
A novel method for crystallizations of aluminum nitride	○ Pei Tsen Wu ・ Mitsuru Funato ・ Yoichi Kawakami (Kyoto Univ.)
トンネル接合を用いた多接合窒化物半導体の検討	○ 黒川泰視 ・ 合田智美 ・ 加賀 充 ・ 岩谷素顕 ・ 竹内哲也 ・ 上山 智 (名城大)・ 赤崎 勇 (名城大/名大)・ 天野 浩 (名大)

11 月 29 日(金) 午前	
赤色発光 Eu 添加 GaN/AlGaIn 多重量子井戸構造の MOVPE 成長と発光特性	○ 荒居孝紀 ・ 若松龍太 ・ 李 東建 ・ 小泉 淳 ・ 藤原康文 (阪大)
有機金属気相エピタキシャル法により作製した Eu,Si 共添加 GaN における欠陥準位の深準位過渡応答測定	○ 桑田宗一郎 ・ 小泉 淳 ・ 藤原康文 (阪大)
加圧 MOVPE 法による InGaIn 厚膜成長に関する研究	○ 山下康平 ・ 本田善央 ・ 山口雅史 ・ 天野 浩 (名大)
薄膜 3C-SiC 緩衝層を用いた Si 基板上 GaN 成長	○ 片桐正義 ・ 泉 健太 ・ 三宅秀人 ・ 平松和政 (三重大)・ 奥 秀彦 ・ 浅村英俊 ・ 川村啓介 (エア・ウォーターR&D)
サファイア上 AlN 緩衝層の N₂-CO アニールと MOVPE 法による高温成長	○ 西尾 剛 ・ 鈴木周平 ・ 三宅秀人 ・ 平松和政 (三重大)・ 福山博之 (東北大)
減圧 HVPE 成長を用いた 6H-SiC 基板上への AlN 成長における核形成制御	○ 北川 慎 ・ 三宅秀人 ・ 平松和政 (三重大)
270nm 帯深紫外 LED の大面積形成	○ 美濃卓哉 (理研/パナソニック)・ 平山秀

	樹(理研) ・ 野口憲路 ・ 高野隆好 ・ 椿 健治 (理研/パナソニック)
透明 p 型 AlGaIn を用いた高効率深紫外 LED の実現	○ 前田哲利 ・ 平山秀樹 (理研)
AlGaIn 系深紫外 LED の開発	○ 一本松正道 ・ 平野 光 (創光科学)・ 天野 浩 (名大)・ 赤崎 勇 (名城大)
高効率深紫外 LED を目指したピラーAIN バッファの開発	○ 豊田史朗 (埼玉大/理研)・ 平山秀樹 (理研)・ 鎌田憲彦 (埼玉大)
ALD-Al₂O₃ を有する InAlN MOS 構造の電気的特性に対する作製プロセスの影響	○ 千葉勝仁 ・ 中野拓真 ・ 赤澤正道 (北大)
ZrO₂/Al₂O₃ 積層膜をゲート絶縁膜に用いた n-GaN MIS ダイオードの界面特性	○ 樹神真太郎 ・ 徳田博邦 ・ 葛原正明 (福井大)
電気化学的手法による GaN 多孔質構造の形成と光電極特性	○ 熊崎祐介 ・ 渡部晃生 ・ 谷田部然治 ・ 佐藤威友 (北大)
GaN-HEMT スwitchング回路における不要電磁波の放射特性の評価	○ 井手利英 ・ 鍛冶良作 ・ 清水三聡 (産総研)・ 水谷研治 ・ 上野弘明 ・ 大塚信之 ・ 上田哲三 ・ 田中 毅 (パナソニック)